

ＴＩＡパワーエレクトロニクス研究拠点
６インチＳｉＣ新ラインが稼働開始

平成 28 年 11 月 4 日
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
住友電気工業株式会社

ＴＩＡ パワーエレクトロニクス研究拠点に平成27年11月より構築を進めていた、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）パワー半導体デバイスの量産開発を可能とする新ラインが完成し、稼働を開始しました。６インチ級の大型ウエハーのプロセスを実現したオープンイノベーション拠点としては、世界初となります。

このラインは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」という）と住友電気工業株式会社（以下「住友電工」という）の両者が相互に連携し竣工しました。基礎研究から一歩進め、世界最先端・最速のＳｉＣパワー半導体の量産技術、信頼性評価技術、品質評価技術の開発を可能とするもので、ＳｉＣパワー半導体の実用化・本格普及による社会イノベーションの推進が期待されます。

当該新ラインを用い、産総研と住友電工は、将来にわたってトップレベルの研究開発を行って参ります。加えて、「ＴＩＡパワーエレクトロニクス研究拠点」の最先端ラインとして、パワエレ産業創出に向けて、我が国産業界が広く利用可能なプラットフォームとして運用してゆく予定です。

<新ラインの主な仕様>

名称：ＴＩＡパワーエレクトロニクス研究拠点 ６インチライン

場所：産総研つくば西事業所 7 群（スーパークリーンルーム研究棟）

面積：クリーンルーム面積 1500 ㎡

付帯設備等 1500 ㎡

仕様：６インチシリコンカーバイド（ＳｉＣ）パワー半導体デバイス量産試作ライン

以 上